

CONDENSATEUR PLAN

On considère un plan (Oxy) infini de densité surfacique de charge σ uniforme.

1) Déterminer le champ électrique $\vec{E}(M)$ créé en tout point M de l'espace.

Correction

On se place en coordonnées cartésiennes $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. Soit un point $M = (x, y, z)$ quelconque de l'espace.

La distribution de charge est invariante par translation selon \vec{u}_x et \vec{u}_y . Donc le champ électrique l'est également.

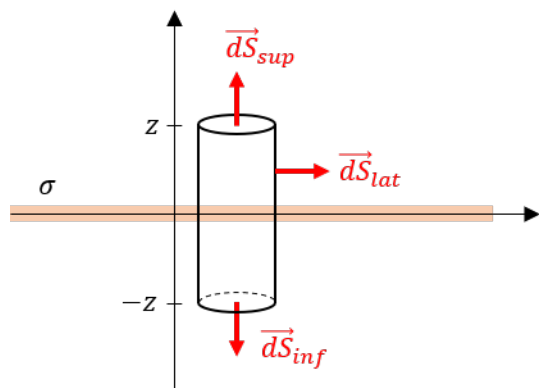
$$\vec{E}(M) = \vec{E}(z)$$

Le plans $(M, \vec{u}_x, \vec{u}_z)$ et $(M, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ sont des plans de symétrie de la distribution de charge (en réalité, tous les plans qui contiennent le point M et le vecteur \vec{u}_z sont des plans de symétrie). Donc $\vec{E}(M)$ appartient à l'intersection de ces plans.

$$\vec{E}(M) = E(z) \vec{u}_z$$

Enfin, le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de charge. Donc $\vec{E}(M)$ est également symétrique par rapport à ce plan. On en déduit : $E(z) = -E(-z)$ et en particulier $E(0) = 0$.

On prend comme surface de Gauss un cylindre de surface S , dont les faces sont respectivement situées en $-z$ et $+z$ (avec $z > 0$). Sa surface se décompose en trois parties : supérieure $\vec{dS}_{sup} = dS \vec{u}_z$, inférieure $\vec{dS}_{inf} = -dS \vec{u}_z$ et latérale $\vec{dS}_{lat} = dS \vec{u}_r$.



Le théorème de Gauss assure que :

$$\oiint \vec{E} \cdot \vec{dS} = \underbrace{\iint_{S_{sup}} \vec{E} \cdot \vec{dS}_{sup}}_{= ES} + \underbrace{\iint_{S_{inf}} \vec{E} \cdot \vec{dS}_{inf}}_{= ES} + \underbrace{\iint_{S_{lat}} \vec{E} \cdot \vec{dS}_{lat}}_{= 0 \text{ car } \vec{E} \perp \vec{dS}_{lat}} = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

On en déduit :

$$E(z > 0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E}(M) = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{si : } z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{si : } z < 0 \\ \vec{0} & \text{si : } z = 0 \end{cases}$$

On s'intéresse maintenant à un condensateur formé de deux disques parallèles conducteurs de rayon R , donc de surface $S = \pi R^2$, situés à une distance e l'un de l'autre. On applique une différence de potentiel U entre les deux disques. Il apparaît des charges opposées sur les armatures $+Q$ et $-Q$. On assimilera le champ créé par chacun de ces plans à celui d'un plan infini.

2) À quelle condition sur e peut-on assimiler le plan créé par un disque à celui d'un plan infini ?

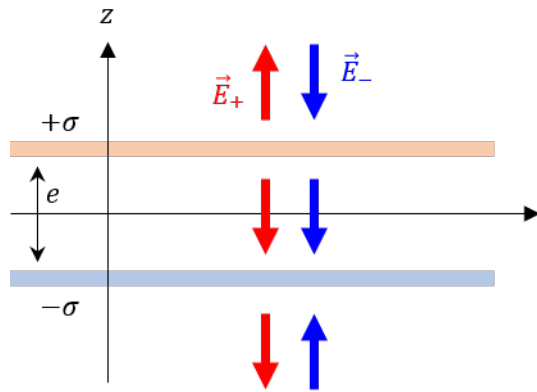
Correction

On peut négliger les effet de bord si $e \ll \sqrt{S}$.

3) Déterminer, sans refaire de calcul, le champ électrique $\vec{E}(M)$ créé en tout point M de l'espace.

Correction

Plaçons les armatures à $\pm \frac{e}{2}$ et notons $\sigma = \frac{Q}{S}$ la charge surfacique de l'armature positive.



D'après ce qui précède, les champs \vec{E}_{\pm} créés par les deux armatures sont :

$$\vec{E}_{+}(M) = \begin{cases} \frac{Q}{2S\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{si : } z > e/2 \\ -\frac{Q}{2S\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{si : } z < e/2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{E}_{-}(M) = \begin{cases} -\frac{Q}{2S\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{si : } z > -e/2 \\ \frac{Q}{2S\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{si : } z < -e/2 \end{cases}$$

D'après le théorème de superposition :

$$\vec{E}_{tot}(M) = \begin{cases} -\frac{Q}{S\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{si : } -e/2 > z > e/2 \\ \vec{0} & \text{sinon} \end{cases}$$

4) En déduire l'expression de la capacité C du condensateur.

Correction

On rappelle la définition de la capacité d'un condensateur :

$$Q = CU \quad \text{avec : } U = V_+ - V_-$$

Or,

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V) \Rightarrow E = -\frac{dV}{dz} \Rightarrow V(z) = \begin{cases} \frac{Qz}{S\epsilon_0} & \text{si : } -e/2 > z > e/2 \\ \frac{Qe}{2S\epsilon_0} & \text{si : } z > e/2 \\ -\frac{Qe}{2S\epsilon_0} & \text{si : } z < -e/2 \end{cases}$$

On en déduit :

$$V_+ - V_- = \frac{Qe}{S\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{C = \frac{S\epsilon_0}{e}}$$